


-
-
- Default operator: OR
- 9 and (implant\$3)
-

#	U	I	Document ID	Issue Date	Pages	Title	Current OR	Current Ref	Retrieval C	Inventor	F	C	P	A	Im
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6420750 B1	20020716	10	Structure and method for buried-strap with reduced ou	257/302	257/327; 257/E21.653;		Divakaruni, Ranachandra et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6417063 B1	20020709	20	Folded deep trench capacitor and method	438/386	257/E21.651; 438/243;		Petter, Robert et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6319700 B1	20011120	35	Semiconductor structure and manufacturing methods	438/386	257/296; 257/E21.396		Gruening, Ulrike et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6310375 B1	20011030	47	Trench capacitor with isolation collar and contacts	257/301	257/300; 257/302;		Schrens, Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6284665 B1	20010904	18	Method for controlling the shape of the etch front in t	438/710	257/E21.312; 257/E21.396;		Lill, Thorsten et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6281539 B1	20010828	25	Structure and process for 6F2 DT cell having vertical	257/302	257/301; 257/E21.652;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6265742 B1	20010724	17	Memory cell structure and fabrication	257/304	257/302; 257/303;		Gruening, Ulrike et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6265741 B1	20010724	16	Trench capacitor with epi buried layer	257/301	257/296; 257/E29.346		Schrens, Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6242310 B1	20010605	10	Method of forming buried-strap with reduced ou	438/268	257/E21.653; 438/269;		Divakaruni, Ranachandra et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6204112 B1	20010320	9	Process for forming a high density semiconductor device	438/243	257/E21.651		Chakravarti, Ashima Bhattacharyya et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6190988 B1	20010220	14	Method for a controlled bottle trench for a dram sto	438/386	438/248; 438/389;		Furukawa, Toshiharu et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6184151 B1	20010206	26	Method for forming cornered images on a substrate and ph	438/743	257/E21.035; 257/E21.036;		Adair, William J. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6180975 B1	20010130	13	Depletion strap semiconductor memory device	257/306	257/296; 257/301;		Radens, Carl J. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6163045 A	20001219	9	Reduced parasitic leakage in semiconductor devices	257/301	257/304; 257/305;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6093614 A	20000725	18	Memory cell structure and fabrication	438/388	257/E21.652; 257/E27.096;		Gruening, Ulrike et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6074954 A	20000613	18	Process for control of the shape of the etch front in t	438/710	257/E21.312; 257/E21.396;		Lill, Thorsten et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6040213 A	20000321	13	Polysilicon mini spacer for trench buried strap formatio	438/243	257/E21.651; 438/246		Canale, Anthony J. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6022781 A	20000208	10	Method for fabricating a MOSFET with raised STI isola	438/296	257/301; 257/305;		Noble, Jr., Wendell P. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US



The screenshot shows the Metasploit Meterpreter interface. At the top, there are buttons for 'Back', 'Forward', 'Quit', and 'Clear'. Below these, the current database is 'USPAT:USPOB'. The search criteria are 'Default operator OR'. The search results are displayed in a table with columns for 'File size' and 'File name'. One result is shown: a file named '11 and implant\$3.cfm' with a size of 11 bytes. The console output shows the search command 'search implant\$3.cfm' and the resulting table.

File size	File name
11	and implant\$3.cfm

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FILE: [Untitled1]

FileViewEditToolsWindowHelp

Active

L1: (118) (deep near trench near capacitor).clm.

L2: (20) 1 and (implant\$3.clm.)

L3: (3491) deep near trench

L4: (1627) 3 and capacitor

L5: (769) 4 and implant\$3

L6: (575) 5 and trench.clm.

L7: (152) 6 and (node near (dielectric or insulat\$3))

L8: (137) 7 and (oxidation or (silicon adj oxide) or (silicon adj dioxide))

L9: (98) 8 and capacitor.clm.

L10: (27) 9 and (collar near dielectric)

USPAT:USPGFUB

Default operator: OR

9 and (collar near dielectric)

USPAT:USPGFUB


	U	I	Document ID	Issue Date	Pages	Title	Current OR	Current Ref	Retrieval C	Inventor	S	C	P	A	Im
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6319787 B1	20011120	14	Method for forming a high surface area trench capacitor	438/386	257/E21.651; 257/E27.092;		Enders, Gerhard et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6310375 B1	20011030	47	Trench capacitor with isolation collar and corresp	257/301	257/300; 257/302;		Schrems, Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6288422 B1	20010911	25	Structure and process for fabricating a 6F2 DRAM cell	257/301	257/302; 257/E21.652;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6281539 B1	20010828	25	Structure and process for 6F2 DT cell having vertical	257/302	257/301; 257/E21.652;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6265741 B1	20010724	16	Trench capacitor with epi buried layer	257/301	257/296; 257/E29.346		Schrems, Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6204112 B1	20010320	9	Process for forming a high density semiconductor device	438/243	257/E21.651		Chakravarti, Ashima Bhattacharyya et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6180975 B1	20010130	13	Depletion strap semiconductor memory device	257/306	257/296; 257/301;		Radens, Carl J. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6163045 A	20001219	9	Reduced parasitic leakage in semiconductor devices	257/301	257/304; 257/305;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6096580 A	20000801	14	Low programming voltage anti-fuse	438/132	257/E23.147; 438/131;		Iyer, S. Sundar Kumar et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6037620 A	20000314	13	DRAM cell with transfer device extending along perim	257/296	257/301; 257/302;		Hoenigschmid, Heinz et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6018174 A	20000125	10	Bottle-shaped trench capacitor with epi buried la	257/296	257/301; 257/309;		Schrems, Martin et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 6008104 A	19991228	30	Method of fabricating a trench capacitor with a depo	438/386	257/E21.651; 438/243;		Schrems, Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5981332 A	19991109	10	Reduced parasitic leakage in semiconductor devices	438/246	257/E27.092; 438/242;		Mandelman, Jack A. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5945704 A	19990831	18	Trench capacitor with epi buried layer	257/301	257/296		Schrems, Martin et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5909044 A	19990601	9	Process for forming a high density semiconductor device	257/301	257/303; 257/E21.651		Chakravarti, Ashima Bhattacharyya et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5362663 A	19941108	11	Method of forming double well substrate plate trench	438/241	257/E27.092; 438/243		Bronner, Gary B. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5264716 A	19931123	12	Diffused buried plate trench dram cell array	257/301	257/304; 257/311;		Kenney, Donald M.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US 5250829 A	19931005	11	Double well substrate plate	257/301	257/305; 257/549;		Bronner, Gary B. et al.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US

Find

Print

Summary

Ready

- 
- The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. At the top, there are tabs for 'Config', 'CLI', 'Ports', 'Tools', and 'About'. The 'CLI' tab is selected. Below the tabs, there are buttons for 'DBs', 'USPAT-USPCPB', 'P-Bus', and 'Highlight all terms in CLI'. The 'DBs' button is selected. In the main area, the command 'l and (implant\$3.cim.)' is entered in the CLI window. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Load', 'Print', 'Exit', and 'Help'.

✓ 800 CHICAGO 437-3333